

# 國立澎湖科技大學第九任校長候選人資料表

## 表一、基本資料

姓名	性別	出生年月日	國籍(含雙重國籍)		
李文熙	男		中華民國		
身分證號碼		護照號碼			
通訊資料	地址： 電話：(公) (宅) 行動電話： 傳真： 電子郵件信箱：				
教授證書 (無則免填)	字號： 起資年月：				
現職	服務機關學校名稱(請填全銜)	現職(職稱)		專、兼任	到職年月日
	亞洲大學	講座教授		專	113/08/01
大學以上學歷(博士)	學校名稱(請填全銜)	院系所	學位名稱	指導者(大學以下免填)	領受學位年月
	交通大學	電子研究所	博士	曾俊元教授	99/06
	中山大學	材料研究所	碩士	沈博彥教授	78/06
	彰化師大	化學系	學士		76/06
教學與行政經歷(擇要至多十五筆)	服務機關學校	職稱(職級)		專任或兼任(含兼職)	任職起迄年月
	亞洲大學	副校長		兼任	113/08-now
	亞洲大學資工系	講座教授		專任	113/08-now
	成功大學電機系	特聘教授		專任	113/03-now
	成功大學半導體學院半導體管理與研發碩士專班	主任		兼任	112/09-113/07
	成功大學 國巨成大共研中心	主任		兼任	109/08-110/07
	成功大學 台積電成大聯合研發中心	執行長		兼任	109/02-110/07
	成功大學創新總中心	副營運長		兼任	109/08-110/07
	成功大學研究總中心	主任		兼任	108/02-109/07
	中興大學產學研鏈結中心	主任		兼任	106/02-108/01
	中興大學材料系	教授		專任	106/02-108/01
	成功大學研發處計管組	組長		兼任	104/02-106/01
	成功大學電機系	(助理、副)教授		專任	92/08-113/02
	飛元科技	協理		專任	89/08-92/07
	飛利浦研發處	經理		專任	88/02-89/07
Germany Philips Aachen Lab	Scientist		專任	87/02-88/01	

表二、著作、作品及發明目錄(請以標楷體繕打，以 1000 字為限)

(一) Conference Paper

1. Narendra Gharini Puteri and Wen-Hsi-Lee “**Research on Additive Manufacturing Plating Technology for 94GHz Array Antennas on LCP Flexible Substrates**” 2025 International Conference on Advanced Green-Energy Materials (2025AGEM)
2. Edward Kuo, Jia-Xiang Zhang, Wen Hsi Lee “**A Novel Additive Technique utilizing Chemical Replacement and Copper Electroplating for CPW and 77 GHz Patch Antenna on LCP Substrate for Medium and Long Range Radar Verification**” 2025 International Conference on Advanced Green-Energy Materials (2025AGEM)
3. W. H. Lee, “**Material Computing on 2D MoTe<sub>2</sub> Phase Control with High Pressure Annealing**” presented at the 1st Conference on Artificial Intelligence in Materials Science and Engineering, Germany 2023. Nov.
4. Narendra Gharini Puteri, Po-Chen Lin, Wen-Hsi-Lee\* “**Air-Sintered Copper-Nickel Resistor with Aluminum Layer for Oxidation Prevention**” International conference on mechanical , material and renewable energy, Atlanta Georgia, 2023 Aug.
5. Shih Syun Chen, Jason Lee, Wen Hsi Lee\* and Kun Jin Huang “**TCAD simulation of different MoTe<sub>2</sub> Layer based on high pressure annealing process for two-dimensional semiconductor device**” International Conference on Scientific Computing, Modeling and Simulation, Boston USA 2023 Aug.
6. S.S. Chen and W. H. Lee, “**Channel Characteristics of Complementary Field Effect Transistor Structure,**” presented at the 3rd Symposium on Nano-Device Circuits and Technologies, SNDCT 2023.
7. S.S. Chen and W. H. Lee, “**Selective deposition of Tellurene onto MoS<sub>2</sub>,**” presented at the 3rd Symposium on Nano-Device Circuits and Technologies, SNDCT 2023
8. Y.-J. Lee, S.-W. Chang, W.-H. Lee and Yeong-Her Wang, “**Heterogeneous IGZO/Si CFET Monolithic 3D Integration,**” 2022 Thin Film Transistors 16 (TFT 16), Electrochemical Society meeting (ECS), Atlanta, Georgia, USA, Oct. 9-13th, 2022.
9. S.-W. Chang, J.-H. Chou, W.-H. Lee, Y.-J. Lee, and D.-D. Lu, “**TCAD-Based RF Performance Prediction and Process Optimization of 3D Monolithically Stacked Complementary FET**”, 2022 Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD), Granada, Spain, Sep. 6-8th, 2022.
10. X.-R. Yu, W.-H Chang, T.-C. Hong, P.-J. Sung, A. Agarwal, G.-L. Luo, C.-T. Wu, K.-H. Kao, C.-J. Su, S.-W. Chang, W.-H. Lu, P.-Y. Fu, J.-H. Lin, P.-H. Wu, T.-C. Cho, W. C.-Yu. Ma, D.-D. Lu, T.-S. Chao, T. Maeda, Y.-J. Lee, W.-F. Wu, W.-K. Yeh, Y.-H. Wang, “**First Demonstration of Vertical Stacked Hetero-Oriented n-Ge (111)/p-Ge (100) CFET toward Mobility Balance Engineering,**” 2022 IEEE Symposium on VLSI Technology (VLSI).
11. S.-W. Chang, P.-J. Sung, T.-Y. Chu, D. D. Lu, C.-J. Wang, N.-C. Lin, C.-J. Su, S.-X. Luo, H.-F. Huang, J.-H. Li, M.-K. Huang, Y.-C. Huang, S.-T. Huang, H.-C. Wang, Y.-J. Huang, J.-Y. Wang, L.-W Yu, Y.-F. Huang, F.-K. Hsueh, C.-T. Wu, W. C.-Y. Ma, K.-H. Kao, Y.-J. Lee, C.-L. Lin, R.W. Chuang, K.-P. Huang, S. Samukawa, Y. Li, W.-H. Lee, T.-S. Chao, G.-W. Huang, W.-F. Wu, J.-Y. Li, J.-M. Shieh, W. -K. Yeh, Y.-H. Wang, “**First Demonstration of CMOS Inverter and 6T-SRAM Based on GAA CFETs Structure for 3D-IC Applications**”, 2019 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), 2019, pp. 11.7.1-11.7.4.
12. Ashish Kumar, Pandi Divya, Wen Hsi Lee “**Consequential effect of MWA and dielectric insertion**

- on Schottky barrier height in Ge MIS structure” SISC 2020 51st IEEE Semiconductor Interface Specialists Conference (SISC), December (16-18), San Diego, USA (Virtual conference)**
13. Ashish Kumar, Wen Hsi Lee, Jia Jing Lin **“Rapid Thermal Annealing effect on significant shift of Schottky barrier height and specific resistance at Metal n-type Germanium interface”** SNDT 2020 27th Symposium on Nano Device Technology, May (19-20), National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan.
  14. TC Kuo, Ashish Kumar, Wen Hsi Lee **“Sheet Resistance and Contact Resistivity of different Palladium Thickness forming in Various Temperature”** IEDMS 2019 International Electron Devices and Materials Symposium October (24-25), New Taipei City, Taiwan.
  15. Ashish Kumar, Yi-Hsin Su, Wen Hsi Lee **“Electrical performance of FinFETs fabricated by the combination of Neutral Beam Etching (NBE) and Microwave annealing”** TPS 2019 Annual Meeting of Physics Society of Taiwan, January (23-25), National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan.
  16. Sovey Chang and Wen-Hsi Lee 2019-The International Symposium on VLSI Technology, Systems and Applications (VLSI-TSA symposium)
  17. Sovey Chang and Wen-Hsi Lee 2019-International Electron Devices Meeting (IEDM)
  18. Sovey Chang and Wen-Hsi Lee 2019-International Electron Devices & Materials Symposium
  19. Sovey Chang and Wen-Hsi Lee 2020-The International Symposium on VLSI Technology, Systems and Applications (VLSI-TSA symposium)
  20. Sovey Chang and Wen-Hsi Lee 2020-International Electron Devices Meeting (IEDM)

## **(二) Journal Article**

1. Wen-Hsi Lee, Chien-Ching Feng, Guan-Fu Chen, and Tai-Chen Kuo **“Study on the fabrication of high-quality hafnium oxide thin films using spatial rotated atomic layer deposition and supercritical fluids treatment”** J. Vac. Sci. Technol. A 42, 062409 (2024); doi : 10.1116/6.0004041
2. Wen-Hsi Lee, Edward Kuo, Chia-Nung Hung, and Tai-Chen Kuo **“Investigating the effects of etching systems and low temperature thermal processing on hafnium zirconium oxide thin film properties”** Vac. Sci. Technol. A 43, 012602 (2025); doi : 10.1116/6.0004040
3. Divya, Pandi ; Lai, Yi Wen ; Lee, Wen-Hsi **“A Novel Additive Technique to Fabricate 24-GHz Array Patch Antenna Using LCP Film”** IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY DOI : 10.1109/TCPMT.2023.3325347"
4. Wen-Hsi-Lee\*, Narendra Puteri, Jason Lee and C.T. Lee **“Studies on Ni termination of a multilayer ceramic capacitor with high capacitance by using DC electrodeposition”** Journal of Electroceramic, : 51 [4] Page : 258-268 DOI : 10.1007/s10832-023-00334-w"
5. .Pandi Divya, Wen-Hsi Lee\*, T.C. Kuo and C.R. Kuo **“A Study on Environmentally Friendly Electroless-Plating”** Journal for Electrochemistry and Plating Technology ,
6. W. H. Lee, **“Characteristic of CuMn Alloy Films Prepared Using Electrochemical Deposition,”** Journal Materials Engineering and Performance, DOI : 10.1007/s11665-023-08445-9"
7. W. H. Lee, **“Fabrication of a flexible RFID antenna by using the novel environmentally-friendly additive process,”** International Journal of Antennas and Propagation, DOI : 10.1155/2023/8477138"
8. Lee, Wen-Hsi and Divya, Pandi and Chen, Shih-Syun and Wang, Y.L., **A Study on High Quality Oxide Film by Spatial Rotated Atomic Layer Deposition(Srald).** Early access at SSRN : [https : //ssrn.com/abstract=4399207](https://ssrn.com/abstract=4399207) or [http : //dx.doi.org/10.2139/ssrn.4399207](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4399207), 2023 Arp.

9. W. H. Lee\*, N. G. Puteri, C. R. Kuo, **“Thick film of modified aluminum with conductivity similar to silver”**, MRS Commun., early access May 2023, doi : 10.1557/s43579-023-00356-z.
10. W. H. Lee, Y. J. Lee, D. D. Lu\* et al, **“3-D Monolithic Stacking of Complementary-FET on CMOS for Next Generation Compute-In-Memory SRAM”**, IEEE J-EDS, vol. 11, pp. 107-113, 2023, doi : 10.1109/JEDS.2022.3230542.
11. Lee, Wen-Hsi\*, Kuo, C. R., Kuo, T. C. **Improvements in the efficiency of p-type bifacial Si solar cells with a rear Cu electrode using galvanic replacement reactions**, SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS, Vol 234, 111411 2022 Jan .DOI : 10.1016/j.solmat.2021.111411
12. W. H. Lee, Y. J. Lee, D. D. Lu\* et al, **“Nanosheet-Compatible Complementary-Field Effect Transistor Logic Non-Volatile Memory Device”**, ECS J. Solid State Sci. Technol., vol. 11(9), no. 095003, Sep. 2022, doi : 10.1149/2162-8777/ac8dbf.
13. A. Kumar, P. Divya, W. H. Lee\*, Y.L. Wang, **“Studies on the electrical characteristics of a high-k dielectric/metal gate MOS capacitor by high-pressure annealing”**, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 61(5), no. 051002, May 2022, doi : 10.35848/1347-4065/ac3a1e.
14. Y.-J. Lee, S.-W. Chang, W.-H. Lee and Yeong-Her Wang, **“Heterogeneous IGZO/Si CFET Monolithic 3D Integration,”** in ECS Transactions, Volume 109, Number 6, 2022.
15. Shu-Wei Chang, Yu-Ming Chang, Wen-Hsi Lee, Yao-Jen Lee and Darsen D. Lu, **“Nanosheet-Compatible Complementary-FET Logic Non-Volatile Memory Device”**, in ECS Journal of Solid State Science and Technology, Volume 11, Number 9, September 2022.
16. Shu-Wei Chang, Tsung-Han Lu, Cong-Yi Yang, Cheng-Jui Yeh, Min-Kun Huang, Ching-Fan Meng, Po-Jen Chen, Ting-Hsuan Chang, Yan-Shiuan Chang, Jhe-Wei Jhu, Tzu-Chieh Hong, Chu-Chu Ke, Xin-Ren Yu, Wen-Hsiang Lu, Mohammed Aftab Baig, Ta-Chun Cho, Po-Jung Sung, Chun-Jung Su, Fu-Kuo Hsueh, Bo-Yuan Chen, Hsin-Hui Hu, Chien-Ting Wu, Kun-Lin Lin, William Cheng-Yu Ma, Darsen D. Lu, Kuo-Hsing Kao, Yao-Jen. Lee, Cheng-Li Lin, Kun-Ping Huang, Kun-Ming Chen, Yiming Li, Seiji Samukawa, Tien-Sheng Chao, Guo-Wei Huang, Wen-Fa Wu, Wen-Hsi Lee, Jiun-Yun Li, Jia-Min Shieh, Jenn-Hwan Tarng, Yeong-Her Wang, Wen-Kuan Yeh, **“First Demonstration of Heterogeneous IGZO/Si CFET Monolithic 3D Integration with Dual Work function Gate for Ultra Low-power SRAM and RF Applications”**, in IEEE Transactions on Electron Devices (TED), vol. 69, no. 4, pp. 2101-2107, April 2022.
17. A. Kumar, P. Divya, W. H. Lee\*, **“Effects of SiNX passivation on GaN-HEMT DC characteristics”**, Mater. Sci. Semicond. Process., vol. 148, no. 106716, Sep. 2022, doi : 10.1016/j.mssp.2022.106716.
18. H. I. Hsiang\*, L. C. Wu, C. C. Chen, W. H. Lee, **“Power Molding Inductors Prepared Using Amorphous FeSiCrB Alloy Powder, Carbonyl Iron Powder, and Silicone Resin”**, Materials, vol. 15(10), no. 3681, May 2022, doi : 10.3390/ma15103681.
19. H. I. Hsiang\*, S. G. Fan, W. H. Lee, **“Fabrication, simulation, and characterization of planar inductors”**, Mater. Today Commun., vol. 29, no. 102929, Dec. 2021, doi : 10.1016/j.mtcomm.2021.102929.
20. C. R. Kuo, T. -C. Kuo and W. -H. Lee\*, **“A Novel Fabricating a Thick Film Cu-Ni Alloy Resistor by Screen Printing an Al Electrode and Galvanic Replacement Reaction,”** in IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 11, no. 11, pp. 1997-2002, Nov. 2021, doi : 10.1109/TCPMT.2021.3121079.
21. A. Kumar, W. H. Lee\*, Y.L. Wang, **“Optimizing the Isotropic Etching Nature and Etch Profile of**

- Si, Ge and Si<sub>0.8</sub>Ge<sub>0.2</sub> by Controlling CF<sub>4</sub> Atmosphere With Ar and O<sub>2</sub> Additives in ICP**", IEEE Trans. Semicond. Manuf., vol. 34(2), pp. 177-184, May 2021, doi : 10.1109/TSM.2021.3057100.
22. A. Kumar, W. H. Lee\*, Y. L. Wang, "Advanced low damage manufacturing processes to fabricate SOI FinFETs and measurement of electrical properties", Microelectronics Reliability, vol. 120, no. 114115, May 2021, doi : 10.1016/j.microrel.2021.114115.
23. T. C. Kuo, C. R. Kuo, W. H. Lee\*, "A Novel Method to Fabricate a Thick-Film Cu Electrode Fired in Air Through Printing Al Electrode and Reduction-Oxidation Substitution Reaction", IEEE Trans. Compon. Packag. Manuf. Technol., VOL. 11(3), PP. 485-492, Mar. 2021, doi : 10.1109/TCPMT.2021.3049495.
24. H. I. Hsiang\*, K. H. Chuang, W. H. Lee, "Magnetic Properties of Iron-Based Alloy Powder Coils Prepared with Screen Printing Using High-Solid-Content Magnetic Pastes", J. Electron. Mater., vol. 50(4), pp. 2331-2338, Apr. 2021, doi : 10.1007/s11664-021-08746-6.
25. Wen-Hsi Lee , S.Q. Tseng Ashish "Influence of plasma UV/VUV irradiation damage on silicon MOS capacitor during etching" J Nanosci Nanotechnol 2021 Apr 1;21(4) : 2163-2173.
26. K C Chuang , Wen-Hsi Lee "Improvement on Conductivity for Thick Film Aluminum Paste" J Nanosci Nanotechnol , 2021 Sep 1;21(9) : 4596-4604. doi : 10.1166/jnn.2021.19162.
27. H. I. Hsiang\*, K. H. Chuang, W. H. Lee, "Titanate coupling agent surface modification effect on the magnetic properties of iron-based alloy powder coil prepared using screen printing", J. Mater. Sci. Mater. Electron., vol. 32(2), pp. 1800-1807, Jan. 2021, doi : 10.1007/s10854-020-04948-6.
28. Po-Jung Sung, Shu-Wei Chang, Chun-Jung Su, Ta-Chun Cho, Fu-Kuo Hsueh, Wen-Hsi Lee, Yao-Jen Lee, and Tien-Sheng Chao, "Fabrication of Vertically Stacked Nanosheet Junctionless Field-Effect Transistors and Applications for the CMOS and CFET Inverters", in IEEE Transactions on Electron Devices (TED), vol. 67, no. 9, pp. 3504-3509, Sept. 2020.
29. W. H. Lee, Y. J. Lee\* et al, "Fabrication of Vertically Stacked Nanosheet Junctionless Field-Effect Transistors and Applications for the CMOS and CFET Inverters", IEEE Trans. Electron Devices., vol 67(9), pp. 3504-3509, Sept. 2020, doi : 10.1109/TED.2020.3007134.
30. K. C. Chung, W. H. Lee\*, "Effect of pretreatment on Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> substrate by depositing Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> film on the properties of Ni-Cr-Si based thin film resistor", Mater. Chem. Phys., vol. 234, pp. 311-317, AUug. 2019, doi : 10.1016/j.matchemphys.2019.05.058.
31. K. J. Jhong, T. W. Chang, W. H. Lee, M. C. Tsai\*, I. H. Jiang, "Characteristic of high frequency Fe-Si-Cr material for motor application by selective laser melting", AIP Advances, vol. 9(3), no. 035317, Mar. 2019, doi : 10.1063/1.5080134.
32. T. C. Kuo\*, K. J. Jhong, C. W. Lin, W. H. Lee, "Effect of annealing conditions on dopants activation and stress conservation in silicon-germanium", AIP Advances, vol. 9(1), no. 015110, Jan. 2019, doi : 10.1063/1.5053237.

### (三) 專利

項次	專利名稱	專利國別	專利證號	專利起訖日
1	晶片電阻端電極結構	美國	9552908	2017/1/24-2035/6/16
2	利用銅之氧化與蝕刻製作微米級細線寬銅質導	中華民國	I583620	2017/5/21-2035/6/8

3	高導電率厚膜鋁膏之製造方法	中華民國	I591653	2017/7/11-2035/11/16
4	車用抗硫化晶片電阻器之製造方法	中華民國	I592953	2017/7/21-2035/6/9
5	車用硫化防止チップ抵抗器の製造方法	日本	特許第 6205390 號	2017/9/8-2035/6/30
6	高導電卑金屬電極或合金低歐姆晶片電阻器之	中華民國	I602202	2017/10/11-2037/4/6
7	晶片電阻端電級結構	中華民國	I603347	2017/10/21-2035/4/9
8	鋁端電極晶片電阻器之製造方法	中華民國	I604471	2017/11/1-2036/11/8
9	可在空氣中燒結高導電率奈米銀包銅厚膜膏之	中華民國	I609381	2017/12/21-2036/2/1
10	高導電卑金屬電極或合金低歐姆晶片電阻器之	美國	9928947	2018/3/27-2037/7/19
11	鋁端電極晶片電阻器之製造方法	韓國	10-1941752	2019/1/7-2036/12/21
12	高導電率厚膜鋁膏之製造方法	美國	10174210	2019/1/8-2035/12/15
13	鋁端電極晶片電阻器之製造方法	日本	特許第 6473732 號	2019/2/1-2036/11/24
14	高導電率卑金屬厚膜導電膏之製備方法	中華民國	I653307	2019/3/11-2037/10/24
15	鋁端電極晶片電阻器之製造方法	美國	10290403	2019/5/14-2036/12/15
16	高??率厚膜?膏的制造方法	中國	ZL201510920252.0	2019/8/13-2035/12/11
17	高導電卑金屬電極或合金低歐姆晶片電阻器之	韓國	10-2021667	2019/9/6-2037/11/10
18	厚膜鋁電極電鍍金屬前處理技術	日本	特許第 6633603 號	2019/12/20-2037/12/20
19	厚膜鋁電極電鍍金屬前處理技術	韓國	10-2079429	2020/2/13-2037/12/21
20	高導電卑金屬電極或合金低歐姆晶片電阻器之	中國	ZL201710263593.4	2020/2/21-2037/4/21
21	鋁端電極晶片電阻器之製造方法	中國	ZL201611192167.8	2020/3/24-2036/12/21
22	高導電率卑金屬厚膜導電膏之製備方法	日本	特許第 6698059 號	2020/4/30-2037/11/8
23	高導電率厚膜鋁膏之製造方法	日本	特許第 6709677 號	2020/5/27-2036/5/5
24	电镀金属前处理的厚膜铝电极	中國	ZL201711390465.2	2021/2/5-2037/12/21
25	電鍍金屬前處理之厚膜鋁電極	中華民國	I733963	2021/7/21-2037/12/11
26	製作積層陶瓷電容器端電極與印刷全面積內電	中華民國	I751089	2021/12/21-2041/6/16
27	積層セラミックコンデンサ端電極の作製と、	日本	7214257	2023/1/20-2031/7/11
28	보호층과 함께 전 면적에 내부 전극이	韓國	10-2531307	2023/5/8-2041/8/25

**表三、學術獎勵及榮譽事蹟(請以標楷體繕打，二者總字數以 1000 字為限)**

**(一) 學術獎勵**

- 99 年 經濟部學界協助中小企業科技關懷計畫優良獎  
100 年 中華民國粉末冶金協會創新獎  
101 年 國科會工程處 101 度技術及知識應用型產學合作計畫優良成果獎  
101 年 經濟部中小企業即時輔導計畫績優獎  
101 年 台灣國際發明得獎會學術國光獎章  
102 年 國科會工程處 102 年技術及知識應用型產學合作計畫傑出成果獎  
102 年 經濟部第三屆國家產業創新獎-基礎技術深耕獎  
104 年 Green Tech. 東元科技最佳創意獎  
105 年 TSMC 四校聯合研發中心競賽佳作獎  
106 年 科技部工程司積層製造研究專案計畫榮獲傑出展示獎  
107 年 電機工程學會傑出工程教授獎  
108 年 成功大學 產學優良獎  
109 年 成功大學 產學優良獎  
111 年 台灣陶業學會服務獎  
111 年 **科技部未來科技獎**  
112 年 台灣陶業學會陶業獎章  
112 年 **經濟部第八屆國家產業創新獎**  
112 年 中國工程師學會傑出工程教授獎  
112 年 成功大學大學創新與大學社會責任教學優良獎  
112 年 **教育部教育家典範**  
113 年 台灣被動元件產業協會卓越創新獎  
113 年 成功大學 產學特優獎  
113 年 **遠見雜誌 大學社會責任產學共榮首獎**

**(二) 榮譽事蹟**

從退伍後自 1991/07 年踏入職場就在高雄台灣飛利浦被動元件研發為首份工作，其中包含一年在德國飛利浦 Aachen 研究室擔任研究員，在產業工作 12 年後，在 2003/ 08 轉進成功大學電機系任職，即使日後從產業轉進學術界仍是以被動元件研究為主要方向，以協助台灣被動元件產業升級為志業，職場歷練包含：

- 學界：國立成功大學電機系教授、成大研究總中心主任、國巨成大共研中心主任、台積電成大聯合研發中心執行長、中興大學 材料工程教授、中興大學產學研中心主任、成大半導體學院半導體管理與研發碩士班主任、亞洲大學副校長
- 協會：南科產業協會秘書長、中科產業協會秘書長、台灣粉末冶金學會監事、台灣被動元件產業協會理事長
- 產業：台灣飛利浦建元電子研發經理、Germany Philip Aachen Scientist，國巨電子研發部協理

因此結合在職場 12 年在產業研發量產實務經歷與 21 年在學術教學研究經歷，包含在校的產學行政六年經歷，進行創新產學合作夥伴新模式為核心，以大學社會責任推動台灣電子產業升級，邁

向全球第一大電子產業為目標，主要成果包含：

1. 創新創業以卑金屬鋁材料為核心打造四代創新技術，榮獲 112 教育部教育家典範人物

進行被動元件產業材料創新，包含電容器、電阻器與利用循環經濟軟板銅導線創新加法碳中和製程的 PCB 產業四代創新技術打入國際大廠 DellNB 供應鏈，衍生三家新創公司募資 9000 萬、專利技轉 2200 萬，總共創造產業市場年產值高達 150 億、建立校園創新創業與達到台灣電子產業上游先進材料自主供應，提升台灣電子產業全球競爭力為目標。

2. 建構產業生態鏈產學合作典範，榮獲遠見雜誌大學社會責任 USR 產學共榮首獎

催生台灣被動元件產業協會，健全台灣被動元件供應鏈系統。攜手半導體、PCB 產業形成護國神山脈。歷經過去五十餘年的努力，耀眼的技術能量與產值已使台灣被動元件產業成為全球第二大被動元件國家；然而面對快速的技術發展與激烈的產業國際競爭，被動元件的產業仍有不少尚待努力的空間。因此，2022 年整合台灣被動元件上下游 80 家廠商，催生成立台灣被動元件產業協會，成為台灣被動元件國家隊，目的是整合產官學全力提升台灣整體被動元件產業全球競爭力，以台灣被動元件產業成為全球第一大被動元件產業為目標，並攜手已是全球第一大的台灣半導體產業及台灣印刷電路板一起建構健全的台灣電子產業供應鏈生態系統，成為台灣的完整的護國神山脈。

3. 鏈結國際頂尖研究中心，躍升台灣研發能量，榮獲 112 經濟部國家產業創新獎

執行科技部產學共研中心計畫，獲得科技部產學共研中心計畫評比執行第一名，擔任國巨成大共同研究中心主任，規劃共同研發新世代被動元件前瞻技術與培訓人才之外，為了讓此共研中心技術研發能量與學術地位可以躍升到國際水準，執行成大國際躍昇計畫成立台灣被動元件研究中心 (Research Center of Taiwan Passive Components), RCTPC，一起共同研發新世代被動元件前瞻技術與培訓被動元件人才之外，為了讓此研究中心技術研發能量與學術地位可以躍升到國際水準，此研究中心與美國兩大被動元件學術重鎮(Penn State、Georgia Tech)密切進行前瞻技術研究跨國合作，並與美國 MIT Nano Lab, 日本 NIMS 及德國 Julich 三大國際一級研究中心鏈結國際合作，透過共同舉辦被動元件國際論壇、研究人員交換、移地研究與聘任國際被動元件講座進行短期來台授課等系列交流活動，全面提升台灣被動元件的研發能量與學術研究成果能到達國際一流水準，躍昇台灣被動元件產業技術層次為世界領導廠商。

4. 研究技術創新，榮獲 111 科技部未來創新獎。

擔任台積電成大聯合研發中心執行長，執行成大-台積電-閩康-UCLA 進行跨國際產學合作，UCLA 進行二維材料分子動力學演算、閩康負責材料與元件維結構分析，成大負責元件模擬與製作，共同以高壓退火前處理製作半金屬相與半導體相二維 MoTe<sub>2</sub> 材料歐姆接觸議題突破。

5. 執行國科會工業 4.2 電子產業供應鏈創新智能低碳技術研發，成立緯創成大共研中心

隨著科技的發展，技術的不斷進步，人工智慧 (AI) 已在製造業領域中發揮著重要作用，AI 是當代具決定性的關鍵技術，成立緯創成大產業 AI 化共研中心合作，讓台灣電子產業供應鏈進行以硬體帶動產業供應鏈淨零碳排，再以軟體 AI 帶動產業供應鏈智能化，達到以軟硬體兼備進行循環產業供應鏈，以提升產業國際競爭力為目標。



6. 教育英才，培育理論與實務兼具人才

指導碩士學生超過 200 人，博士學生 20 人，開設產業微波通訊與光電半導體產業碩士專班共 12 年，服務廠商超過二十家，幫產業培訓產學無縫接軌專業工程師超過 200 人才。指導學生 Narendra 博士班學生榮獲 112 台灣陶業年會論文競賽博士組佳作，指導張書維博士班學生榮獲 2023 TSIA 半導體獎，指導學生王政凱碩士班學生榮獲 111 國巨論文競賽佳作，指導張書維博士班學生榮獲台積電 2020 博士獎學金 250 萬(2020)，指導學生甘佳鑫碩士班學生榮獲 110 台灣陶業年會論文競賽碩士組第三名(2021)。

7. 協助亞洲大學成立智慧半導體設計與永續智慧製造中心與成功招募國際學生來台學習

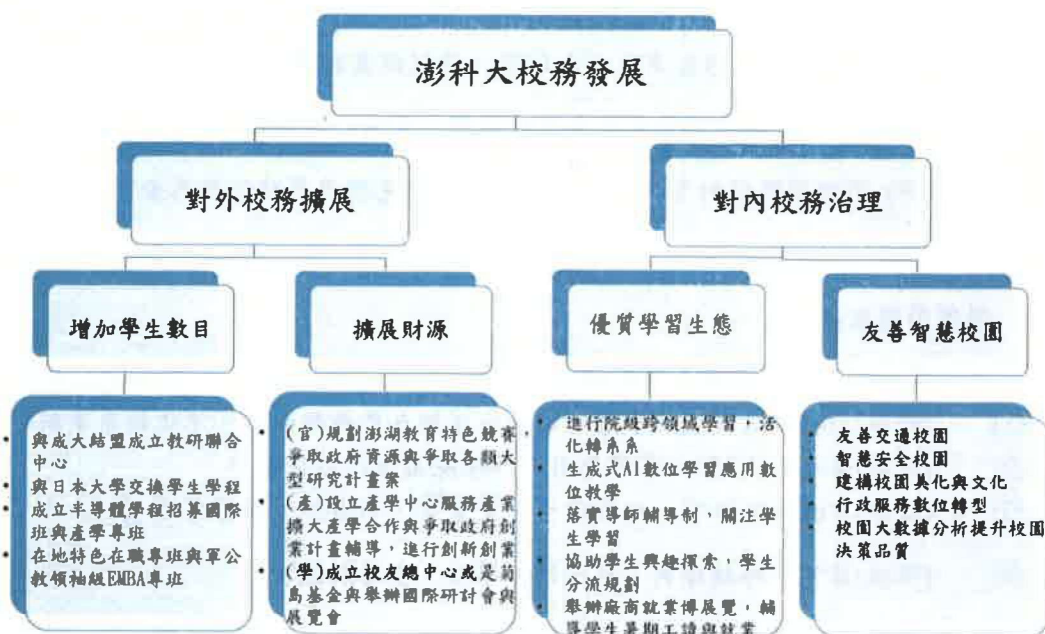
配合教育部新南向政策對內亞洲大學成立半導體智慧半導體設計與永續智慧製造中心，整合校內資電學院、管理學院師資規劃亞洲大學半導體設計與半導體智慧製造 2+2 學程，對外鏈結中部半導體產業與亞洲大學產學聯盟，提供學生半導體實習場域，對國際進入東南亞與日本招募半導體國際學生來台學習半導體，成功招募越南 FPT 大學來台與亞洲大學簽約，越南 FPT 大學每年有幾百位越南學生到亞洲大學學習半導體設計學程與半導體智慧製造學程。

## 表四、治校理念摘要

(請以標楷體繕打，以 3000 字為限，另精簡摘要 500 字以內俾利刊登公報)

### 一、精簡摘要(500 字以內)：

校務發展分成對校外的校務擴展與對內的校務治理兩部分，在對外校務擴展主要針對如何增加學生數目與增加校務基金兩大目標，在對內校務治理主要是針對校園軟體優質學生態與硬體友善智慧校園環境兩大目標。



#### (一) 對外校務擴展

主要是提升學生註冊率與增加學生總額，並擴展學校財源

##### 1. 增加學生數目

主要是針對導入外部資源提升澎科大吸引力來提高學校註冊率，

並配合政府大南方新矽谷與離島低碳樂活政策規劃，成立半導體相學程招募國際學生，並為了提升在地產業競爭力，招募在地休閒旅遊，海洋科學、綠能低碳產業在職專班學生，來提升學校學生總數目。

- (1) 提高註冊率，結盟國內頂大成立教研聯合中心與產業學院及，並鏈結國際日本大學交換學生或雙聯學位提升澎科大教育品質
- (2) 增加學生總額，設立半導體相關學程學習招募東南亞、印度國際學生來台進行 2+2 國際交換學程，針對澎湖在地產業與居民需求，開設特色在職專班如旅遊休閒、軍公教領袖級高階管理碩士專班(與遠見影響領到力學院合作)、海洋科學、綠能低碳。

## 2. 擴展財源

主要從政府經費補助申請、產學合作育創新創業與凝聚校友成立總校友中心，及舉辦在地特色國際研討與展覽會來擴展校務基金。

- (1) (官)規劃澎湖教育特色競賽，爭取政府資源
- (2) (官)爭取政府國科會、經濟部、教育部各類大型研究計畫案
- (3) (產)設立產學中心以單一窗口服務產業擴大產學合作規模
- (4) (產)爭取政府創業計畫的輔導，以澎湖特色產業為主題如海洋科學、低碳綠能、休閒旅遊領域，鼓勵師生爭取政府萌芽、價創創業計畫
- (5) (學)成立校友總中心或是菊島基金凝聚校友向心力協助學校發展
- (6) (學)舉辦國際研討會與展覽會提升學校可見度與累積校務基金

### (二) 對內校務治理

#### 1. 優質學習生態

主要是從教師教學與學生學習輔導兩面向

- (1) (教學)進行院級跨領域學習，讓學生了解自己興趣領域，活化轉系系統。
- (2) (教學)生成式 AI 數位學習應用於各學院系進行數位教學
- (3) (教學)紮根通識教育、培育學生人文素養、養成終生學習習慣
- (4) (學務)落實導師輔導制，關注學生學習、生活狀況。
- (5) (學務)協助學生興趣探索，進行學生升學、就業生涯分流規劃
- (6) (學務)舉辦廠商就業博覽會，輔導學生暑期工讀與就業

#### 2. 友善智慧校園

主要分成校園硬體改善與軟體導入校園行政數位轉型兩面向

- (1) (硬體)友善交通校園
- (2) (硬體)智慧安全校園
- (3) (硬體)建構校園美化與文化
- (4) (軟體)行政服務數位轉型、重新整合校務行政系統
- (5) (軟體)校園大數據分析提升校園決策品質

## 二、治校理念摘要(3000字為限)：

### 1.提高新生註冊率達到8成以上

引進外部資源提高澎科大招生吸引力包含：

#### (1) 與頂大結盟

##### a. 成立成大-澎科大教研聯合中心

台灣少子化趨勢下高教的挑戰甚鉅，賦予大學新的大學社會責任。

- 成功大學新大學社會責任：協助離島資源不足的大學，帶領這些大學可以渡過台灣少子化的招生壓力與強化他們的國際競爭力。
- 澎湖科大新社會責任：配合行政院擘劃均衡台灣藍圖中的大南方新矽谷與低碳樂活離島兩大政策發揮科技大學職人精神，協助培育台灣電子產業工程人才嚴重不足的困境提供本島居民可以多元終身學習學程的教育環境。

##### b. 設立產業學院，以成大為核心學校，澎科大為夥伴學校一起培育台灣電子產業工程師人才(台北-正崙-電子代工、新竹-捷創-半導體量測、台中-友威-半導體設備、台南-魁鼎-半導體設備)

#### (2) 與日本大學交換學生或雙聯學位(九州大學、福岡工業大學)

##### a. 與九州大學已有跟台灣科大、台灣師大碩士交換學程 1.5+0.5

##### b. 與澎科大規模相當福岡工業大學 教師 150 位，學生 4000 人，學生就業率 99.6%為國際交流合作標的。

### 2.提高學校學生總數目

#### (1) 設立電子半導體相關學程

##### a. 以台灣金字招台半導體學程學習招募東南亞、印度國際學生來台進行 2+2 國際交換學程。

##### b. 招募產業專班，針對產業人才培育與人力缺口需求，開設各類在職進修專班與產學訓實習專班。

#### (2) 針對澎湖在地產業與居民需求

##### a. 開設特色在職專班如旅遊休閒、軍公教領袖級高階管理碩士專班(與遠見影響領到力學院合作)、海洋科學、綠能低碳。針對澎湖特殊產業生態，透過澎科大海洋、旅遊休閒科系與管理學院學習來達到產業升級與提升創造價值。

##### b. 教育部第三人生大學 在邁入澎湖人口超高齡社會，鼓勵終身學習，藉由第三人生大學，協助壯世代發揮所長、實現自我價值，並營造友善的終身學習環境，進一步活化運用中高齡人力資源。

### 3.爭取學校資源與經費

透過產官學爭取經費包含：

#### (1) (官)規劃澎湖教育特色競賽，爭取政府資源

發揮澎湖特色包含海洋保育、環境科學、永續發展、地方傳統工藝、故事創作(口述歷史)、文創產品設計、數位科技的地方觀光行銷、智慧海洋管理系統設計，綠能科學、與其他政府鼓勵舉辦適合澎湖特色的相關競賽。

- (2) (官)爭取政府國科會、經濟部、教育部各類大型研究計畫案  
 研發處規劃以獎助方式積極鼓勵師生爭取政府各種計畫補助專案，結合學校研究優勢與各部門計畫重點，明確申請計畫的核心方向，整合校內不同學科的專家，並結合外部產業或校外夥伴，共同提出具有創新性與實際影響力的研究計畫。
- (3) (產)設立產學中心以單一窗口服務產業擴大產學合作規模  
 為了服務產業以學校單一窗口成立產學中心方便產業連結學校資源服務產業，將學校研究成果鏈結產業應用，規劃學生產業實習，無縫接軌產業，深化產學合作內容，創造產學雙贏。
- (4) (產)爭取政府創業計畫的輔導  
 以澎湖特色產業為主題如海洋科學、低碳綠能、休閒旅遊領域，鼓勵師生爭取政府萌芽、價創創業計畫，結合在地產業，推動創新創業，有助於促進地方經濟發展，提升學校與社區的合作效益，並培育具市場競爭力的人才。
- (5) (學)成立校友總中心或是菊島基金凝聚校友向心力協助學校發展  
 邀請校友成立校友總中心，以校友擔任總會長與分會會長，定期舉辦校友會活動，聯絡校友感情與向校友報告校務發展，凝聚校友對於學校向心力，可以仿成大校友成立鳳凰基金投資獲利一定比例捐贈回饋母校，協助母校發展。
- (6) (學)舉辦國際研討會與展覽會提升學校可見度與累積校務基金  
 主題應與澎湖或是學校的專業領域或研究強項緊密相關，突出澎湖或學校特色如澎湖國際學術研討會—海洋文化遺產國際交流，建立學校內外專業人士組成的活動策劃團隊，負責活動的專業規劃與執行，主動與企業、政府部門或其他教育機構聯繫，尋求合作機會。學校不僅能夠提升影響力，還能持續為校務運營與發展提供資金支持，形成良性循環。

#### 4 優質教學與學習環境

- (1) 進行院級跨領域學習，讓學生了解自己興趣領域，活化轉系系統。  
 大學進行院級跨領域學習的目的是為了提供學生更多探索興趣與多元發展的機會，同時活化轉系系統，讓學生能更靈活地調整學習方向，學生能主動探索並選擇符合自身興趣的學習路徑，學習積極性大幅提高，學生的學習內容多樣化後，更能應對現代社會對跨領域人才的需求
- (2) 生成式 AI 數位學習應用於各學院系進行數位教學  
 強化學習體驗，透過互動性與個性化設計，學生能更有效掌握知識。創新教學模式，結合模擬與實境體驗，讓課程設計更靈活有趣。
- (3) 紮根通識教育、培育學生人文素養、養成終生學習習慣  
 紮根通識教育、培育人文素養與養成終生學習習慣，三者相輔相成，共同塑造全面而平衡的教育體系。這不僅能幫助學生在學術與職場中取得成功，更能培育具有文化內涵、社會責任感與學習動力的世界公民。
- (4) 落實導師輔導制，關注學生學習、生活狀況。  
 導師應以開放、包容的態度與學生互動，讓學生感到安全與被尊重，落實導師輔導制是促進學生全人發展的重要舉措，透過關注學習與生活情況，導師能幫助學生在校園內外找到方向與支持，培育他們成為身心健康、學業優秀且具備適應能力的社會成員。

(5) 協助學生興趣探索，進行學生升學、就業生涯分流規劃

學校透過興趣探索與升學、就業生涯分流規劃，幫助學生在重要的學業與人生階段中做出符合自身需求的選擇。這不僅能增強學生的學習動力與就業競爭力，也有助於他們在未來的學術與職場生涯中獲得長足的成長與成功。

(6) 舉辦廠商就業博覽會，輔導學生暑期工讀與就業

舉辦廠商就業博覽會並輔導學生暑期工讀與就業，是學生邁向職場的重要一步。這不僅能幫助學生更好地銜接學校與社會，也為企業發掘優秀人才提供了便利。通過這一舉措，學校能有效支持學生的全人發展，促進教育與職場的無縫接軌。

## 5 友善智慧化校園環境

### (1) 友善交通校園

- a. 校園內交通工具：提供共享腳踏車、電動滑板車、電動車等，讓學生能夠快速移動且減少碳排放。
- b. 公共交通連結：校園周邊設有便利的公共交通站點，並與當地交通系統緊密連結，服務學校師生。
- c. 停車與綠化空間：設立充足整齊的停車空間與充裕的綠地，營造舒適的校園環境。
- d. 無障礙設施：設置無障礙通道與電梯，為行動不便人士提供友善的交通環境。

### (2) 智慧安全校園

- a. 建立智慧校園基礎架構  
高速網絡與雲端服務，部署高速校園 Wi-Fi，確保全校無縫覆蓋，支持大規模數據傳輸。利用雲端平台提供數據存儲、共享與計算能力，降低校內硬體設施需求。
- b. 提升校園安全與環境管理，智慧安防系統，部署高解析度攝像頭、人臉識別技術和智能警報系統，提高安全性。環境監控使用 IoT 技術監測校園空氣質量、溫度、光線等，營造健康舒適的學習環境。

### (3) 建構校園美化與文化

建構校園特色美化與文化是學校發展是重要，它不僅可以提升學校的視覺吸引力，還有助於培養學生的歸屬感與文化認同，探討學校的歷史、地理位置、社區特色，將這些元素融入校園文化。

### (4) 行政服務數位轉型

- a. 建立數位化服務平台  
整合行政系統：校務行政系統建置，將個別系統（畢業生流向、單一系統登入、主計系統、人事差勤系統、ecampus 系統…）完成整合，並將學生管理、財務、課程安排、人事、後勤等系統整合為一個統一的數位化服務平台，實現數據共享與流程自動化，提供在線服務，減少人工處理流程。
- b. 利用人工智慧行政數位轉型  
分析修課大數據：應用大數據分析預測註冊人數變化，學習表現、課程選修趨勢、課程需求或學生輔導需求，優化學校資源配置與行政規劃。  
智慧客服系統：利用 AI 聊天機器人處理常見問題，例如課程查詢、校園服務指南，降低人力負擔。

(5) 校園大數據分析提升校園決策品質

- a. 提升校園決策的科學性，透過收集並分析學生學習數據、校務運作數據等，可以為校方提供具體且可操作的決策支持。
- b. 個性化教育支持，透過分析學生的學習行為和成績數據，提供個性化學習建議，有效地預測學生可能需要學術支持或供輔導產業資源分類。
- c. 增強學校競爭力，校園大數據分析能有效地顯示出學校的發展特色與重點，有助於招募更多優秀的學生與教師。

註：本表如不敷使用，請自行延伸。

候選人簽名：

